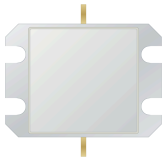
5700–7100 MHz GaN 内部整合型パワートランジスタ — PSAT 51 dBm (標準値)

LCT-5700-7100-PS51T · 5700–7100 MHz · GaN 内部整合型パワートランジスタ.



RF 電気特性表の規定値: PSAT 51 dBm (標準値); 電力利得 11 dB (標準値); PAE 45 % (標準値). RF 測定条件: TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs.

CMW025B

ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。

Vg: C = 10 µF

RF 特性

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	f	5700	-	7100	MHz
飽和出力電力	-	50.5	51	-	dBm
電力利得	-	10.5	11	-	dB
電力付加効率	-	40	45	-	%
電力利得平坦度	-	-	-	1.5	dB

DC バイアスと電流

項目	記号	最小値	代表値	最大値	値	単位
ドレイン動作電圧	-	-	-	-	28	V
ゲート動作電圧	-	-	-	-	[-3.2, -2.4]	V

絶対限界値

限界値であり、通常動作の設定値ではありません。

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大ドレイン・ソース間電圧	-	-	-	32	V
ゲート・バイアス下限	-	-5	-	-	V
保存温度	-	-65	-	150	°C
最大入力電力	-	-	-	42	dBm

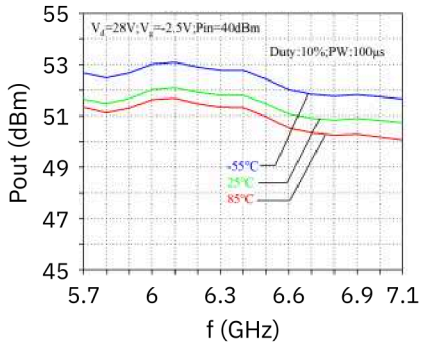
現在の発行記録 · 1.5 · 2026-11-12. 製品説明または編集内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.4.

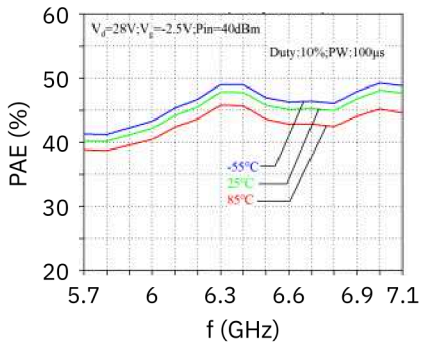
実装上の注意

CMW025B ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。 Vg: C = 10 µF G: RF入力 D: RF出力 S: ソース／グランド

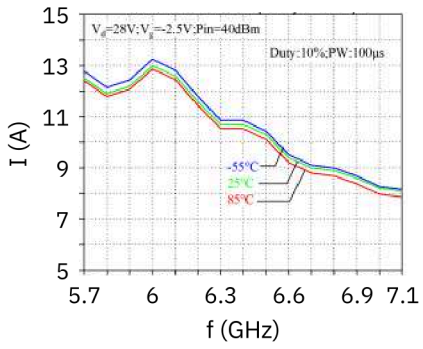
性能特性曲線

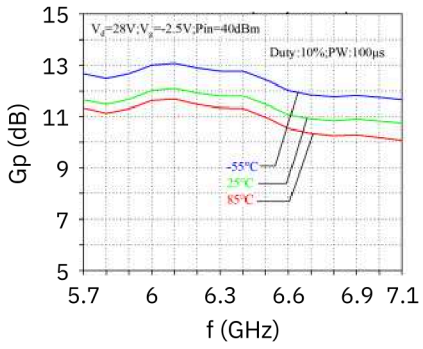
各図に記載された動作条件と併せてご確認ください。



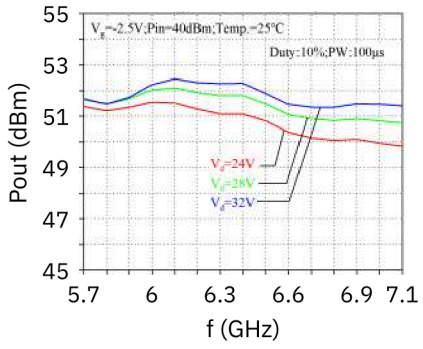


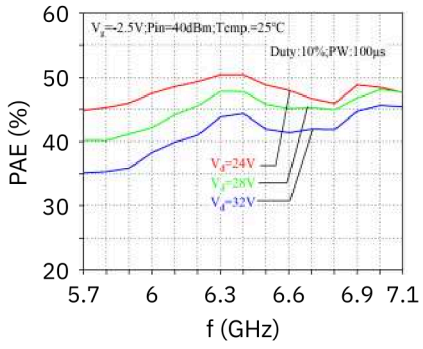
−55°C 25°C 85°C





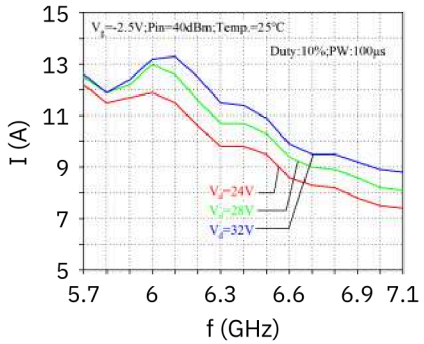
−55°C 25°C 85°C

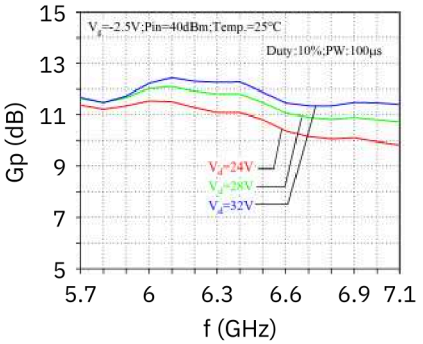




24 V 28 V 32 V

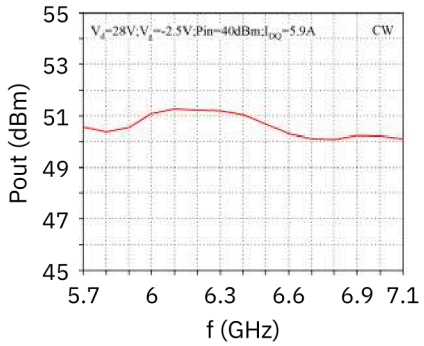
出力電力、電力付加効率、ドレイン電流、電力利得。 図1–4：Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs; Temp = −55 / +25 / +85°C. 図5–6：Vd = 24 / 28 / 32 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; Temp = +25°C; D = 10%; PW = 100 µs.

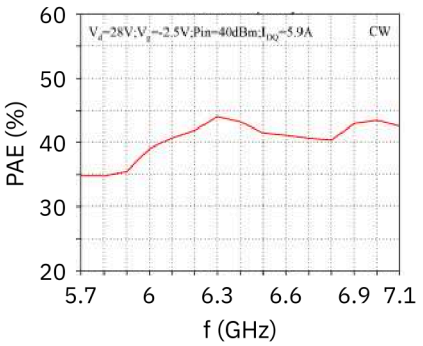


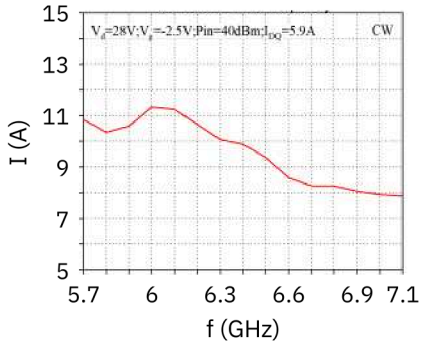


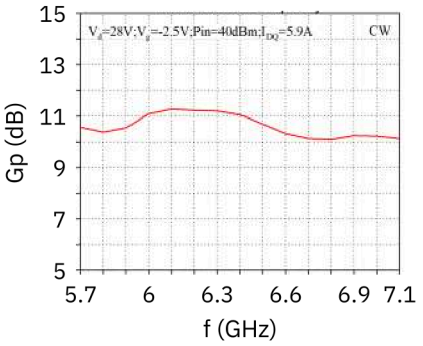
24 V 28 V 32 V

24 V 28 V 32 V

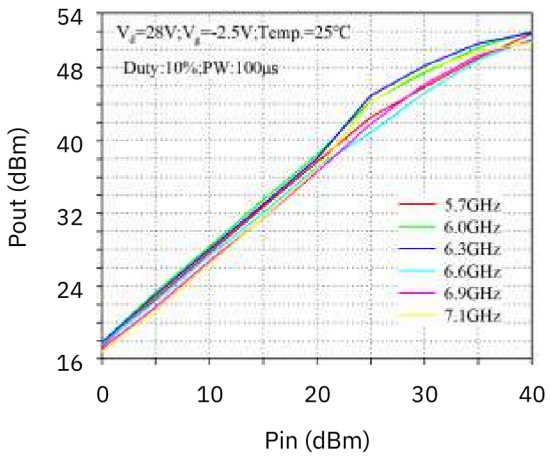


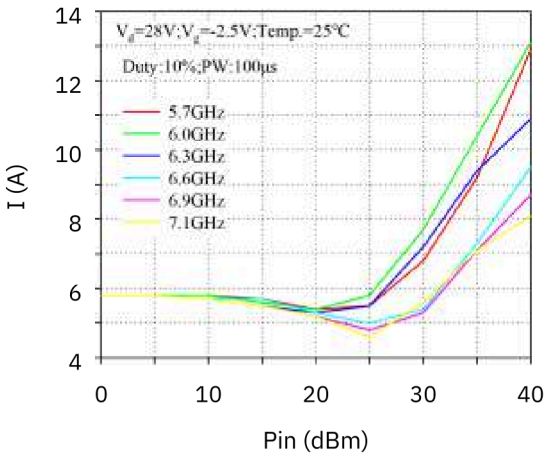






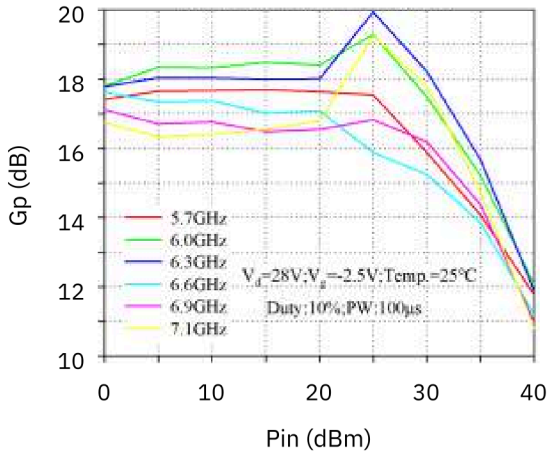
出力電力、電力付加効率、ドレイン電流、電力利得。 図1–2：Id, Gp; Vd = 24 / 28 / 32 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; Temp = +25°C; D = 10%; PW = 100 µs. 図3–6：Pout, PAE, Id, Gp; Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; IDQ = 5.9 A; CW.





5.7 GHz 6.3 GHz 6.9 GHz
6.0 GHz 6.6 GHz 7.1 GHz

5.7 GHz 6.3 GHz 6.9 GHz
6.0 GHz 6.6 GHz 7.1 GHz



5.7 GHz 6.3 GHz 6.9 GHz
6.0 GHz 6.6 GHz 7.1 GHz

出力電力、ドレイン電流、電力利得。 Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Temp = +25°C; D = 10%; PW = 100 µs; Pin = 0–40 dBm.

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。